EAT1A-10

极高频高压二极管

反向电压：10 kV，正向电流：1 A，反向恢复时间：35 ns

Extreme-Fast Recovery High Voltage Diode

Reverse Voltage：10 kV

Average Forward Current：1 A

Maximum Reverse Recovery Time：35 ns

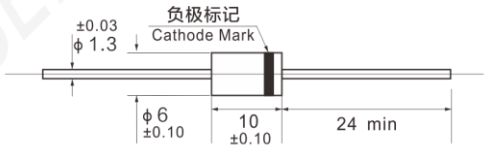
技术资料
Technical Data

- 产品级别：外贸级
- 封装形式：环氧封装
- 引线：轴向
- 极性：色环指示负极

- Product Grade: International Standard
- Package Type: Epoxy Encapsulation
- Lead: Axial Lead
- Polarity: Cathode Indicated by Color Band

产品标准
Product Standard

Q/FT TRV0003-2022《高压二极管》



单位：mm

HVD-610

验收标准
Acceptance Criteria

GB/T 4023-1997《半导体器件分立器件和集成电路 第 2 部分：整流二极管》

Semiconductor Devices-Discrete Devices and Integrated Circuits-Part 2: Rectifier Diodes

外形尺寸
External Dimensions

封装代号：HVD-610；详见右图

Package Code：HVD-610；Please refer to the figure on the right.

HVS HIGH VOLTAGE SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

Add：Building 5, Zone 1, No.6 Shagang Street, Fang Shan District, Beijing, China 102403

Email：sale@hvs-semicon.com

Tel：8610-67538299

Mobile：86 15801604498

Website: www.hvs-semicon.com

特性及参数值
Characteristics and Parameter

除非另有规定，环境温度均为 25℃。
The ambient temperature is 25℃ unless otherwise specified.

电气特性 Electrical Characteristics	符 号 Symbol	额定值 Ratings	单 位 Unit
最大反向重复峰值电压 Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	10	kV
最大反向不重复峰值电压 Maximum Non-repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	11	kV
最大正向平均电流 Maximum Average Forward Current （@ T_{oil} = 55℃）	$I_{F(AV)}$	1	A
最大正向浪涌电流 Maximum Forward Surge Current	I_{FSM}	60	A
最大正向峰值电压 Maximum Peak Forward Voltage （@ $I_F = I_{F(AV)}$ ）	V_{FM}	≤ 20	V
最大直流反向电流 Maximum DC Reverse Current （@$V_R = V_{RRM}$）	I_R	≤ 2 (T_a = 25℃)	μA
		≤ 30 (T_{oil} = 100℃)	
最大反向恢复时间 Maximum Reverse Recovery Time （I_F = 0.5A，I_R = 1A）	trr	≤ 35	ns
有效工作结温 Operating Junction Temperature Range	T_J	－55 ~ ＋125	℃
贮存温度 Storage Temperature Range	T_{STG}	－55 ~ ＋150	℃

HIGH VOLTAGE SEMICONDUCTOR